

CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX TRANSISTORS

DE FABRICATION FRANÇAISE

Le dernier Salon de la Pièce détachée Radio a montré à ses visiteurs l'effort de l'industrie française dans le domaine des semi-conducteurs, et présenté un certain nombre de nouveautés. Les études actuellement menées se poursuivent dans trois directions principales :

- Accroissement de la fréquence.
- Augmentation de la puissance.
- Etude de transistors au silicium.

Dans le domaine de l'accroissement de la fréquence, le centre de Recherches Physico-chimiques de Puteaux de la C.S.F. présente deux nouvelles structures.

a) Structure à base diffusée.

Il semble bien qu'au delà de 100 Mc/s, les procédés s'apparentant aux techniques d'alliage soient définitivement dépassés et que c'est l'utilisation des techniques de diffusion qui apportera la solution.

Dans l'élément présenté par cette firme, la base est obtenue par une couche de germanium « N » d'épaisseur 1 micron environ, diffusée sur du germanium « P ».

Le contact de base et l'émetteur sont réalisés en évaporant sur la base 2 surfaces rectangu-

laire d'or et d'aluminium de 25×100 microns séparées par une distance de 12 microns. On attend de cet élément des fréquences de coupure de plusieurs centaines de Mc/s.

b) Structure unipolaire Alcatron.

Cet élément fait partie d'un programme de recherches concernant les structures à effet de champ, structures qui permettent d'espérer des puissances supérieures à celles obtenues avec les éléments à base diffusée pour des fréquences identiques et qui ouvrent la voie de l'utilisation de matériaux semi-conducteurs autres que Ge et Si.

L'Alcatron est une structure de forme annulaire qui donne d'ores et déjà, des fréquences intéressantes avec une géométrie qui n'est plus du domaine de la microscopie et laisse donc espérer des puissances notables.

Augmentation de la puissance.

Poursuivant ses études sur les transistors de forte puissance, les laboratoires C.S.F. réalisent des prototypes d'un transistor 15 A, dont les performances sont équivalentes à celles du 2 N 174 de Delco. Ce transistor pourra tenir des tensions de 80 V. et couvrira ainsi une large gamme d'utilisation de transistors en puissance.

Etude de transistors au silicium.

Des études se poursuivent sur l'utilisation des techniques de diffusion pour la réalisation de transistors au silicium. Des prototypes ont été réalisés dont la fréquence de coupure est de l'ordre de 15 Mc/s et qui sont capables de dissiper plusieurs watts.

Mais avant que ces maquettes et prototypes doivent devenir dans un proche avenir du domaine de la production courante nous pensons intéresser nos lecteurs en présentant les principaux types de transistors, de construction française, actuellement mis à leur disposition. Nous espérons ainsi les inciter à devenir des adeptes des semi-conducteurs et à se familiariser avec les circuits d'utilisation de ces nouveaux éléments.

Transistors HF et MF.

La nouveauté essentielle de la production du Département Semi-Conducteurs de la C.S.F. est constituée par les transistors DRIFT 30 Mc/s (PNIP au germanium). Ces transistors ont une fréquence de coupure de 30 Mc/s. Ils permettent, en particulier, de constituer les étages HF des récepteurs recevant la gamme des ondes courtes de 13 m à 50 m.

TABLEAU I
TRANSISTORS HF ET MF

Type	Jonctions	Tension collecteur-base max (V)	Courant collecteur max (mA)	Gain nominal en courant (β)	Fréquence nominale de coupure (base commune) F_{α} (Mc/s)	Applications principales	Fabrication
OC 44	PNP	— 15	— 10	100 ($-I_c = 1$ mA)	15	Mélangeur-oscillateur Amplification FI Commutation rapide Commutation rapide Commutation rapide Usages généraux	Radiotechnique
OC 45	PNP	— 15	— 10	50 ($-I_c = 1$ mA)	6		
OC139	NPN	20	250	> 20 ($I_c = 15$ mA)	> 3,5		
OC140	NPN	20	250	> 50 ($I_c = 15$ mA)	> 4,5		
OC141	NPN	20	250	> 100 ($I_c = 15$ mA)	> 9		
OC170	PNP	— 20	— 10	80 ($I_c = 1$ mA)	70		
SFT106	PNP	— 18	— 50	30	3		
SFT107	PNP	— 18	— 50	50	6		
SFT108	PNP	— 18	— 50	80	10		
SFT115	DRIFT	40	10	60	30		
SFT116	DRIFT	24	10	60	30		
SF5117	DRIFT	24	10	60	30		
SFT118	DRIFT	24	10	60	30		
SFT119	DRIFT	24	10	60	30		
SFT120	DRIFT	24	10	60	30		
SFT126	PNP	— 24	— 250	30 ($-I_c = 1$ mA)	5		
SFT127	PNP	— 24	— 250	50 ($-I_c = 1$ mA)	7		
SFT128	PNP	— 24	— 250	80 ($-I_c = 1$ mA)	10		
2N135	PNP	— 20	— 50	20	3	Amplification FI Amplification FI Amplification FI Amplification FI Amplification FI Amplification FI	Thomson-Houston
2N136	PNP	— 20	— 50	40	5		
2N137	PNP	— 10	— 50	60	7		
THP61	NPN	15	25	—	2		
THP62	NPN	15	25	—	2		
THP35	NPN	30	—	—	3		
THP36	NPN	30	—	—	5		

TABLEAU II
TRANSISTORS BF

Type	Jonctions	Tension collecteur-base max (— V)	Courant collecteur max (— mA)	Gain nominal en courant (β)	Fréquence de coupure (base commune) F_{α} (kc/s)	Dissipation collecteur (mW) à 25°C	Applications principales	Fabrication	
OC 57	PNP	7	10	50 (— $I_c = 0,5$ mA)	500	10	Prothèse auditive Prothèse auditive Prothèse auditive Amplification Amplification	Radiotechnique	
OC 58	PNP	7	10	65 (— $I_c = 0,5$ mA)	650	10			
OC 59	PNP	7	10	90 (— $I_c = 0,5$ mA)	900	10			
OC 70	PNP	30	50	30 (— $I_c = 0,5$ mA)	450	125			
OC 71	PNP	30	50	47 (— $I_c = 0,5$ mA)	500	125			
OC 72	PNP	32	125	70 (— $I_c = 10$ mA)	> 350	165			Amplification de sortie et commutat.
2-OC 72									
OC 74	PNP	20	300	100 (— $I_c = 50$ mA)	1 500	555			Amplification de sortie
2-OC 74									
OC 75	PNP	30	55	90 (— $I_c = 3$ mA)	700	125			Amplification Commutation Commutation Commutation pour courants forts
OC 76	PNP	32	250	70 (— $I_c = 10$ mA)	> 350	165			
OC 77	PNP	60	250	70 (— $I_c = 10$ mA)	> 350	165			
OC 80	PNP	32	600	100 (— $I_c = 50$ mA)	> 1 000	555			
SFT101	PNP	24	150	30		100	Amplification Faible puissance (pré-amplis et drivers)		
SFT102	PNP	24	150	50		100			
SFT103	PNP	24	150	80		100			
SFT121	PNP	24	250	30		150	Faible puissance Push-Pull classe B jusqu'à 500 mW	C.S.F.	
SFT122	PNP	24	250	50		150			
SFT123	PNP	24	250	80		150			
SFT130	PNP	24	500	30		550	Moyenne puissance Push-Pull classe B jusqu'à 2 W		
SFT131	PNP	24	500	70		550			
SFT124	PNP	24	500	30		350			
SFT125	PNP	24	500	70		350			
SFT141	PNP	45	250	30 (— $I_c = 100$ mA)	800	200	Amplification basse fréquence ou commutation lente	C.S.F.	
SFT142	PNP	45	250	50 (— $I_c = 100$ mA)	1 000	200			
SFT143	PNP	45	500	30 (— $I_c = 250$ mA)	800	350			
SFT144	PNP	45	500	50 (— $I_c = 250$ mA)	1 000	350			
SFT145	PNP	45	750	30 (— $I_c = 250$ mA)	800	550			
SFT146	PNP	45	750	50 (— $I_c = 250$ mA)	1 000	550			

TABLEAU III
TRANSISTORS BF
Thomson-Houston

	2N43	2N44	2N186	2N187	2N188	2N-186A	2N-187A	2N-188A	2N189	2N190	2N191	2N192	2N265
Limites absolues d'utilisation													
Dissipation admissible au collecteur à 25°C (mW)	150	150	75	75	75	180	180	180	75	75	75	75	75
Tension entre collecteur et base (V)	— 45	— 45	— 25	— 25	— 25	— 25	— 25	— 25					
Tension entre émetteur et base (V)			— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5					
Tension entre collecteur et émetteur ($R_{cb} = 1$ k Ω) (V)									— 25	— 25	— 25	— 25	— 25
Courant collecteur (mA)	50	50	200	200	200	200	200	200	50	50	50	50	50
Caractéristiques moyennes à 25°C													
Tension collecteur (V)	— 5	— 5	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12	— 12
Courant émetteur (mA)	1	1							1	1	1	1	1
Gain max. en puissance (en E.C.) (dB)	40	39	28	30	32	28	30	32	37		41		
Montage en E.C. classe A													
Impédance d'entrée base à émetteur ($I_E = 1$ mA) (k Ω)									1	1,4	1,8	2,2	4
Gain de courant ($V_{ce} = -5$ V, $I_E = 1$ mA)									24	36	54	75	110
Montage E.C. symétrique classe B													
Puissance de sortie max. pour distorsion < 5 % (mW)			300	300	300	750	750	750					
Impédance d'entrée (signal fort) pour $\Delta I_E = 150$ mA (k Ω)			1,2	2	2,6	1,2	2	2,6					
Gain de courant ($V_{ce} = 1$ V, $I_c = 150$ mA)			24	36	54	24	36	54					
Fréquence de coupure en B.C. (Mc/s)			0,8	1	1,2	0,8	1	1,2	0,8		1,2		

Citons : le SF-T 116 pour amplificateurs H.F. jusqu'à 10 Mc/s; Le SF-T 117 pour oscillateurs jusqu'à 23 Mc/s; le SF-T 118 pour étages mélangeurs jusqu'à 10 Mc/s; le SF-T 119 pour amplificateurs M.F. à 455 kc/s; le SF-T 120 pour convertisseurs de haute fréquence.

La Radiotechnique présente le nouveau transistor PNP OC170 dont la fréquence de coupure s'élève à 70 Mc/s, et les transistors de la série OC 139, OC 140, OC 141, du type N-P-N par alliage, de construction tout verre. Ces transistors de structure symétrique ont été étudiés pour des circuits de commutation rapide à haut courant. Ces transistors ont une structure qui leur confère des propriétés bilatérales. Par conséquent, les deux contacts du type N peuvent être utilisés soit comme émetteur, soit comme collecteur.

En ce qui concerne les caractéristiques électriques, il y a, en général, une légère différence entre les deux sens, due à de petits écarts de symétrie. Aussi ces transistors ont un côté collecteur préféré qui est indiqué par un point rouge sur l'enveloppe.

Les transistors OC 139, OC 140 et OC 141 ont été étudiés en vue d'application à la commutation sur des signaux forts. Ils se caractérisent donc par une bonne régularité de leur amplification de courant jusqu'aux valeurs élevées du courant de collecteur.

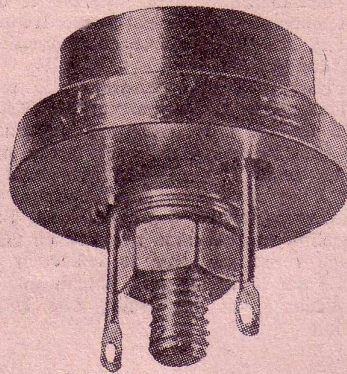
En ce qui concerne le changement de fréquence, nous avons le choix entre l'OC 44 de la Radiotechnique, le 2 N 135 de la Thomson-Houston et le SF-T 108 de la C.S.F., dont la fréquence de coupure est de 10 Mc/s. L'amplification M.F. offre un choix important d'échantillons; OC 45 à la Radiotechnique, SF-T 106 et SF-T 107 à la C.S.F., 2N 135, 2N 136, 2N 137 à la Thomson auxquels il faut ajouter le THP 61 et le THP 62, transistors à jonction NPN au silicium destinés à fonctionner à des températures élevées, qui viennent s'ajouter aux transistors de même type THP 35 et THP 36.

Transistors BF de moyenne puissance

Parmi les nouveautés, les transistors de moyenne puissance de la CSF SF-T 130 et 131 permettent de constituer des étages B.F. de

sortie push-pull, classe B, délivrant une puissance de l'ordre de 2 W sur haut-parleur. Ces transistors sont particulièrement conçus pour les électrophones portables. La CSF continue à présenter de nombreux autres types de la série SF-T tels que le SF-T 101, SF-T 102, SF-T 103 qui permettent d'obtenir une puissance de sortie de 100 mW.

De son côté, la Radiotechnique poursuit la fabrication de ses deux types bien connus



Transistor de puissance

OC70 et OC71, tandis que la Thomson-Houston nous offre ses nouveaux transistors 2N190, 2N192 et 2N265.

Pour l'étage final symétrique classe B des récepteurs, les types OC72 et OC74 de la Radiotechnique, les types SF-T 121, SF-T 122, SF-T 123, de la CSF, et les 2N186, 2N187, 2N188 de la Thomson-Houston permettent d'atteindre des puissances de sortie s'élevant au maximum à 500 mW. Pour les puissances supérieures, on trouve, chez cette firme, les 2N186A, 2N187A et 2N188A, dont la puissance de sortie peut s'élever à 750 mW, et chez la C.S.F., les types SF-T 130 et SC-T 131 qui, en push-pull, classe B, peuvent donner une puissance de sortie s'élevant à 2 W.

Transistors de puissance

Les transistors de puissance SF-T 113, SF-T 114 et SF-T 150 de la C.S.F. permettent de constituer des étages de sortie B.F. délivrant une puissance de 4 W sur haut-parleur en classe A, une puissance de 10 W sur haut-parleur, avec un montage push-pull, classe B. Ces transistors sont avantageusement utilisés dans les récepteurs auto-radio. Chez la Thomson, les types THP45, THP46, THP47 sont particulièrement recommandés pour la commande des relais, des convertisseurs de tension, des oscillateurs, des amplis BF de puissance. La température maximum de la jonction est de 85°C. Dans tous les cas, ces transistors doivent être montés sur une plaque métallique de 50 x 50 afin d'assurer un refroidissement normal. Si le collecteur doit être isolé de la masse, celui-ci étant réuni au boîtier, on intercalera une rondelle de mica entre le boîtier et le châssis. Afin d'assurer une meilleure conductivité thermique, on enduira cette rondelle de graisse silicone.

La Radiotechnique continue à présenter le transistor OC16, qui peut fournir une puissance de sortie de 2,5 W en classe A et 8 W en montage symétrique classe B. Ce type est complété par l'OC19, l'OC26, l'OC27, ces deux derniers permettant d'atteindre une puissance de sortie de 4 W, et plus récemment par le type OC 30 qui délivre 1 W en classe A et jusqu'à 4 W en montage symétrique classe B.

Conclusion

Les semi-conducteurs s'affirment chaque jour davantage comme éléments de choix dans le domaine de l'électronique.

La production industrielle des transistors témoigne de la maîtrise acquise dans la technologie de fabrication cependant que les laboratoires mènent des travaux de recherches visant à l'amélioration des performances.

La gamme, déjà étendue, des semi-conducteurs de fabrication française, permet de satisfaire un grand nombre de besoins et d'exigences de l'industrie de l'électronique.

TABLEAU IV

TRANSISTORS DE PUISSANCE

Types	Jonctions	Tension collecteur-base max (— V)	Courant collecteur max (— mA)	Temps max. de la jonction (°C)	Gain moyen courant (β)	Résistance thermique (K°C/W)	Applications principales	Fabrication
OC 16	PNP	32	3	75	35 (— I _c = 0,3 A)	1,2	Applications B F Applications B F Amplification de sortie (4 W) Amplification de sortie (4 W) Commutation pour courants forts Commutation pour courants forts Applications BF	Radiotechnique
OC 19	PNP	32	3	75	35 (— I _c = 0,3 A)	1,2		
OC 26	PNP	32	3,5	90	40 (— I _c = 1 A)	1,2		
OC 27	PNP	32	3,5	90	90 (— I _c = 1 A)	1,2		
OC 28	PNP	80	6	90	50 (— I _c = 1 A)	1,2		
OC 29	PNP	80	6	90	60 (— I _c = 1 A)	1,2		
OC 30	PNP	32	1,4	75	36 (— I _c = 0,1 A)	7,5		
SFT113	PNP	30	3	75	40 (— I _c = 1 A)	2	Amplification de puissance Classe B : 10 W	C.S.F.
SFT114	PNP	60	3	75	40 (— I _c = 1 A)	2		
SFT150	PNP	80	3	75	40 (— I _c = 1 A)	2		
THP44	PNP	12	—	—	—	—	Classe A : 4 W et Amplification de puissance	Thomson-Houston
THP45	PNP	15	—	85	20 (— I _c = 2 A)			
THP46	PNP	30	—	85	20 (— I _c = 2 A)			
THP47	PNP	60	—	85	20 (— I _c = 2 A)			